

AVR513 : ATmega165からATmega165Pへの移植

要点

- 一般的な移植の考慮
- レジスタとビット名
- メモリ
- クロック元
- I/Oピン

1. 序説

この応用記述はATmega165からATmega165Pへの移植時に関連する相違点を要約します。デバイスの詳細情報については各々のデータシートをご覧ください。

ATmega165PはATmega165とピンと機能が互換であるべく設計されていますが、本応用記述で言及する改良のため、ATmega165からATmega165Pへの移植時に応用での微細な修正が必要になるかもしれません。

2. 一般的な移植の考慮

可能な限り容易な移植処理を行うには、デバイスからデバイスへで絶対的なアドレスと値が変わり得るため、常に定義名を使ってレジスタとビット位置を参照することを推奨します。設計移植時、たまたその都度正しい定義ファイルをインクルードすることが必要です。いくつかの例が以下で示されます。

```

PORTE |= (1<<PORTE5); //ポートEのビット5をHighに設定
DDRE  &= ~(1<<PORTE5); //ポートEのビット5を入力設定
// USI初期化
USICR = (1<<USISIE) | (0<<USIOIE) | (1<<USIWM1) | (0<<USIWM0) |
        (1<<USICS1) | (0<<USICS0) | (0<<USICLK) | (0<<USITC);
  
```

追加した機能とレジスタ機能での矛盾を避けるために、予約として記されたレジスタを決してアクセスしてはなりません。アクセスする場合、予約ビットは常に0が書かれるべきです。これは将来互換を保証し、追加機能は未使用時にそれらの既定状態に留まります。



8ビット **AVR**[®]
マイクロコントローラ

応用記述

本書は一般の方々の便宜のため有志により作成されたもので、Atmel社とは無関係であることを御承知ください。しおりのはじめにでの内容にご注意ください。

Rev. 8064A-03/07, 8064AJ3-04/21

3. レジスタ名とビット名

ATmega165とATmega165P間でいくつかのレジスタビットが追加されていますが、既存ビットの削除も、違う位置への移動もありません。ATmega165でのUSARTはUSARTと名付けられ、一方ATmega165PでのそれはUSART0と呼ばれます。これは全てのUSARTのレジスタ名とビット名に対して当然の結果で、使うコンパイラによってはコード移植時に重要かもしれません。表3-1.はATmega165とATmega165Pに対するレジスタ名を示します。

表3-1. USARTレジスタ名

ATmega165		ATmega165P		ATmega165		ATmega165P	
レジスタ名	ビット名	レジスタ名	ビット名	レジスタ名	ビット名	レジスタ名	ビット名
UCSRA	RXC	UCSR0A	RXC0	UCSRC	-	UCSR0C	-
	TXC		TXC0		UMSEL		UMSEL0
	UDRE		UDRE0		UPM1		UPM01
	FE		FE0		UPM0		UPM00
	DOR		DOR0		USBS		USBS0
	UPE		UPE0		UCSZ1		UCSZ01
	U2X		U2X0		UCSZ0		UCSZ00
	MPCM		MPCM0		UCPOL		UCPOL0
UCSRB	RXCIE	UCSR0B	RXCIE0	UDR	RXB7~0	UDR0	RXB07~0
	TXCIE		TXCIE0		TXB7~0		TXB07~0
	UDRIE		UDRIE0	UBRRH	UBRR11~8	UBRR0H	UBRR011~8
	RXEN		RXEN0	UBRRL	UBRR7~0	UBRR0L	UBRR07~0
	TXEN		TXEN0				
	UCSZ2		UCSZ02				
	RXB8		RXB80				
	TXB8		TXB80				

4. メモリ

EEPROM書き込み時間が異なり、これは表4-1.で見れます。

表4-1. EEPROM書き込み時の待機時間

デバイス	代表的な書き込み時間
ATmega165	8.5ms
ATmega165P	3.3ms

5. クロック元

ATmega165Pに関するクロック元はATmega165と異なる特性を持ち、考慮されなければならないかもしれません。相違点は以降の副項で記述されます。

5.1. 校正付き内蔵RC発振器

ATmega165Pの校正付き内蔵RC発振器はATmega165と異なる設計を基にしています。OSCCALレジスタは7ビットに代わって8ビットで、最上位ビットが2つの重なる周波数範囲を選択します。この発振器の校正の情報についてはデータシートを参照してください。

5.2. 低周波数クリスタル用発振器、タイマ/カウンタ用発振器

ATmega165Pの低周波数クリスタルとタイマ/カウンタ用発振器は非常に低い電力消費に最適化され、従ってこのクリスタル駆動部の能力はATmega165に比べて減少されています。これはクリスタル選択時に負荷容量と等価直列抵抗(ESR)が注意深く考慮されなければならないことを意味します。両方の値はクリスタル供給者によって指定されます。表5-1.はATmega165Pに対する推奨ESRを示します。ATmega165Pの低周波数用発振器の内部容量は代表的に6pFですが、クリスタルへの経路(配線)が或る付加容量を追加するでしょう。

表5-1. 32.768kHzクリスタルに対する推奨負荷容量とESR

クリスタル CL	最大ESR (注)
6.5 pF	60 kΩ
9 pF	35 kΩ

注: 述べられた値は5kΩの安全域を許容する発振器用です。この発振器のトランスコンダクタンスは温度補償されているので、4kΩの安全域が使え、従って各々75kΩと45kΩの最大ESRを与えます。

この必要条件に対応するクリスタルの例については「付録A」をご覧ください。

表5-2.で示されるように起動時間も延長されています。

表5-2. 32.768kHzクリスタルでの起動時間

クリスタル CL (pF)	起動時間 (ms) (注)	
	ATmega165	ATmega165P
6.5	-	800
9	300	1200
12.5	400	-

注: 通常、クリスタルはどんな発振器設計でもそれらが完全に安定するのに先立って、~3000msが必要です。述べられた値はクリスタルが十分な振幅と周波数安定度で走行する以前です。

6. I/Oピン

ATmega165Pは外部リセット機能を禁止する任意選択を持ちます。そしてRESETピンは入力専用ピンになります。このリセット禁止機能はATmega165で利用できません。

7. 付録A

表7-1.はATmega165PのESR必要条件に合致するクリスタルの選択品です。クリスタルはデータシート情報を基に一覧にされ、ATmega165Pで試験されていません。ESR必要条件に対応する他のどんなクリスタルも使えます。入手性とRoHS適合は調査されていません。

表7-1. ATmega165Pの低周波数クリスタル用発振器の必要条件に適合するクリスタル

供給者	型式	実装 (SMD/穴)	周波数誤差 (\pm ppm)	負荷容量 (pF)	等価直列抵抗(ESR) (k Ω)
C-MAC	WATCH CRYSTALS	穴	20	6	50
C-MAC	85SMX	SMD	20	6	55
C-MAC	90SMX	SMD	20	6	60
ECLIPTEK	E4WC	穴	20	6	50
ENDRICH	90SMX	SMD	5	6	50
EPSON	C-001R	穴	20	6	35
EPSON	C-002RX	穴	20	6	50
EPSON	C-004R	穴	20	6	50
EPSON	C-005R	穴	20	6	50
EPSON	MC-30A	SMD	20	6	50
EPSON	MC-306	SMD	20	6	50
EPSON	MC-405	SMD	20	6	50
EPSON	MC-406	SMD	20	6	50
GOLLEDGE	GWX	穴	5	6	35
GOLLEDGE	GSWX-26	SMD	10	6	35
GOLLEDGE	GDX1	穴	10	6	42
GOLLEDGE	GSX-200	SMD	5	6	50
IQD	WATCH CRYSTALS	穴	20	6	50
IQD	90SMX	穴	10	6	60
IQD	91SMX	穴	10	6	60
MICROCRYSTAL	MS2V-T1R	穴	20	7	65
MICROCRYSTAL	MS3V-T1R	穴	20	7	65
MMD	WC26	穴	8	6	35
MMD	WCSMC	SMD	20	6	50
OSCILENT	SERIES 111	穴	10	6	30
OSCILENT	SERIES 112	穴	10	6	40
OSCILENT	SERIES 223	SMD	20	6	50
RALTRON	SERIES R38	穴	5	6	35
RALTRON	SERIES R26	穴	5	6	35
RALTRON	SERIES RSE A,B,C,D	SMD	20	6	50
SBTRON	SBX-13	SMD	20	6	50
SBTRON	SBX-20	SMD	20	6	50
SBTRON	SBX-21	SMD	20	6	50
SBTRON	SBX-24	SMD	20	6	50
SBTRON	SBX-23	SMD	20	6	50
SBTRON	SBX-22	SMD	20	6	50
SBTRON	SBX-14	穴	20	6	50
SUNTSU	SCT1	穴	20	6	40
SUNTSU	SCT2	穴	20	6	50
SUNTSU	SCT3	穴	20	6	50
SUNTSU	SCP1	SMD	20	6	50
SUNTSU	SCT2G	SMD	20	6	50



本社

Atmel Corporation

2325 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131, USA
TEL 1(408) 441-0311
FAX 1(408) 487-2600

国外営業拠点

Atmel Asia

Unit 1-5 & 16, 19/F
BEA Tower, Millennium City 5
418 Kwun Tong Road
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong
TEL (852) 2245-6100
FAX (852) 2722-1369

Atmel Europe

Le Krebs
8, Rue Jean-Pierre Timbaud
BP 309
78054 Saint-Quentin-en-Yvelines
Cedex
France
TEL (33) 1-30-60-70-00
FAX (33) 1-30-60-71-11

Atmel Japan

104-0033 東京都中央区
新川1-24-8
東熱新川ビル 9F
アトメル ジャパン株式会社
TEL (81) 03-3523-3551
FAX (81) 03-3523-7581

製造拠点

Memory

2325 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131, USA
TEL 1(408) 441-0311
FAX 1(408) 436-4314

Microcontrollers

2325 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131, USA
TEL 1(408) 441-0311
FAX 1(408) 436-4314

La Chantrerie
BP 70602
44306 Nantes Cedex 3
France
TEL (33) 2-40-18-18-18
FAX (33) 2-40-18-19-60

ASIC/ASSP/Smart Cards

Zone Industrielle
13106 Rousset Cedex
France
TEL (33) 4-42-53-60-00
FAX (33) 4-42-53-60-01

1150 East Cheyenne Mtn. Blvd.
Colorado Springs, CO 80906, USA
TEL 1(719) 576-3300
FAX 1(719) 540-1759

Scottish Enterprise Technology Park
Maxwell Building
East Kilbride G75 0QR
Scotland
TEL (44) 1355-803-000
FAX (44) 1355-242-743

RF/Automotive

Theresienstrasse 2
Postfach 3535
74025 Heilbronn
Germany
TEL (49) 71-31-67-0
FAX (49) 71-31-67-2340

1150 East Cheyenne Mtn. Blvd.
Colorado Springs, CO 80906, USA
TEL 1(719) 576-3300
FAX 1(719) 540-1759

Biometrics

Avenue de Rochepleine
BP 123
38521 Saint-Egreve Cedex
France
TEL (33) 4-76-58-47-50
FAX (33) 4-76-58-47-60

文献請求

www.atmel.com/literature

© Atmel Corporation 2007.

Atmel製品は、ウェブサイト上にあるAtmelの定義、条件による標準保証で明示された内容以外の保証はありません。本製品は改良のため予告なく変更される場合があります。いかなる場合も、特許や知的技術のライセンスを与えるものではありません。Atmel製品は、生命維持装置の重要部品などのような使用を認めておりません。

本書中の®、™はAtmelの登録商標、商標です。
本書中の製品名などは、一般的に商標です。

© HERO 2021.

本応用記述はAtmelのAVR513応用記述(doc8064.pdf Rev.8064A-03/07)の翻訳日本語版です。日本語では不自然となる重複する形容表現は省略されている場合があります。日本語では難解となる表現は大幅に意識されている部分もあります。必要に応じて一部加筆されています。頁割の変更により、原本より頁数が少なくなっています。

必要と思われる部分には()内に英語表記や略称などを残す形で表記しています。

青字の部分はリンクとなっています。一般的に赤字の0,1は論理0,1を表します。その他の赤字は重要な部分を表します。